

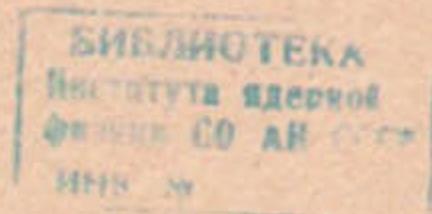
Б.26

И Н С Т И Т У Т
ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ СОАН СССР

И Я Ф 10 - 71

С.Е.Бару, Ю.В.Коршунов, Г.А.Савинов

СХЕМОТЕХНИКА ЭЛЕМЕНТОВ ГИБРИДНО-
ИНТЕГРАЛЬНОЙ СЕРИИ 217



Новосибирск

1971

С.Е.Бару, Ю.В.Коршунов, Г.А.Савинов

СХЕМОТЕХНИКА ЭЛЕМЕНТОВ ГИБРИДНО-ИНТЕГРАЛЬНОЙ СЕРИИ 217

АННОТАЦИЯ

Кратко изложена схемотехника гибридно-интегральных схем серии 217. Приведены схемы формирователей, генераторов, одновибраторов, счётчиков, элементов задержки и тд. Даны графики и эмпирические формулы.

Любые вычисления за исключением схемы в КЛАС и ИСИ ведутся, что необязательно приводит к более простым системам. Рассмотренные схемы разработаны для микропроцессорных систем (микропрограммные языки - ДЛП) серии 217, обладающих рядом языковых возможностей.

Логические схемы Соколовой конфигурации на базе полевого транзисторного распределенного схемы 20-30 логик.

2. Однокомандное устройство.

3. Трехразрядные сдвиговые регистры.

4. Четырехразрядный делитель (ДР-4).

5. Четырехразрядные сумматоры (с учетом переноса), дифференциальные схемы (ДЛП/1).

6. Четырехразрядные сдвиговые регистры с различными (входами) параллельной входной линией.

Несколько малые схемы серии 217 рассчитаны на работу с "полупроводниковыми" микропрограммами, т.е. "1" во входах представляют высокий уровень, а "0" - низкий уровень ("импульс").

Все логические операции схемы имеют логическую структуру, подобную логическим функциям ИЛИ, ИЛИ-НЕ, ИЛИ-НЕ-НЕ.

Возможна определенная "стартовая" или "запускочная" схема, в которой некоторые из входов должны некоторым образом быть заряжены до единицы.

Использование гибридно-интегральных (ГИС) и интегральных (ИС) схем в ядерном приборостроении существенно повышает надежность и технологичность аппаратуры.

Достоинства ГИС и ИС очевидны:

1. Увеличение надежности аппаратуры, обусловленное многоступенчатым контролем каждого компонента схемы во время изготавления. Схемы производятся в едином, тщательно отработанном технологическом процессе. Поэтому сложные логические схемы имеют интенсивность отказов порядка 10^{-7} 1/час. /1/.

2. Значительное уменьшение объема и стоимости монтажных работ, связанное с возможностью широкого применения печатного монтажа. Кроме того, монтируются не дискретные компоненты схем, а уже готовые блокмодули.

3. Практическое отсутствие этапов макетирования и наладки готовой аппаратуры.

Анализ имеющихся в нашем распоряжении данных о ГИС и ИС показал, что наиболее привлекательными для проектирования системы регистрации являются гибридно-интегральные модули (диодно-транзисторная логика - ДТЛ) серии 217, обладающие рядом достоинств:

1. Приемлемое быстродействие - время задержки распространения сигнала 20-30 нсек.

2. Однополярное питание.

3. Потенциальные связи элементов.

4. Высокий коэффициент разветвления (до 8).

5. Высокая помехоустойчивость, характерная для схем ДТЛ/1/.

6. Два типа триггеров (со счетными и раздельными входами) с разветвленной входной логикой.

Нормально модули серии 217 рассчитаны на работу с "положительными" импульсами, т.е. "1" на входе соответствует высокий уровень, и "0" - низкий уровень ("земля").

В этом случае логические функции всех модулей соответствуют указанным в паспортах.

Возможно использование "отрицательных импульсов"; в этом случае логическая функция модуля может быть определена по извест-

ным соотношениям

$$\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$$

$$\overline{A} \cdot \overline{B} = \overline{A} + \overline{B}$$

Например, наиболее употребительный модуль 2ЛБ172 при работе с "положительными" импульсами осуществляет логическую функцию ЗИ - НЕ

$$f(A, B, C) = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$$

Подавая на вход 2ЛБ172 "отрицательные" импульсы, получим модуль, осуществляющий логическую функцию ИЛИ:

$$f(A, B, C) = \overline{\overline{A}} \cdot \overline{\overline{B}} \cdot \overline{\overline{C}} = \overline{\overline{A}} + \overline{\overline{B}} + \overline{\overline{C}} = A + B + C$$

Особо следует остановиться на характере нагрузочной способности модулей серии 217. В соответствии со структурой ГИС этого типа нагрузка должна включаться между выходом модуля и напряжением питания. В противном случае (включение R_h к "земле") в режиме "1" даже при $R_h = R_k = 1,5$ ком выходной сигнал будет ниже порога уверенного срабатывания последующего элемента (+ 1,5 в).

В настоящей работе кратко изложена схемотехника элементов серии 217 - включение линий задержки, формирование импульсов из фронтов, построение генераторов, одновибраторов, двоично-десятичных счётчиков и т.п. В приводимых ниже схемах используются модули 2ЛБ172. На рис.1 приведены схема модуля и его условное изображение.

1. ЗАДЕРЖКА

1. Включение линии задержки

Согласование линий задержки при применении их с элементами серии 217 затруднено, т.к. входы элементов - нелинейные сопротивления (диоды). Минимальное рассогласование может быть получено при использовании низкоомных линий задержки (с волновым сопротивлением 600 ом). В этом случае влияние входа модуля, подключенного к согласующему сопротивлению, уменьшается.

Простой способ включения линии задержки показан на рис.2. Графики рис.3 (сплошные линии) отражают вполне удовлетворительную картину прохождения и задержки импульса.

Включение эмиттерного повторителя (рис.4) уменьшает отражение на выходе линии задержки (точка 2), улучшает нижний уровень проходящего импульса (точка 3), что увеличивает надежность работы модуля 2. В этом случае к выходу линии задержки можно подключить несколько модулей. Влияние эмиттерного повторителя на форму импульсов в схеме отражено на рис.3 (пунктир).

В схемах рис.2 и рис.4 к первому модулю нельзя подключать напряжение питания "+ 3 в".

2. Задержка импульса по переднему фронту

С подачей отрицательного импульса на вход схемы (рис.5) триод модуля 1 закрывается; ёмкость C начинает заряжаться до 3-х вольт с постоянной времени

$$\tau = RC \quad \text{где}$$

$R \approx 750$ ом (ёмкость C заряжается не только через коллекторное сопротивление модуля 1, но и током входной цепи модуля 2). Поскольку триод модуля 2 открывается, когда напряжение в точке 2 становится равным 1,4 в (см.рис.7), то

$$t_{\text{задержки}} \approx 0,5 \tau \quad (\text{см.рис.6})$$

Длительность переднего фронта задержанного импульса можно определить по приближенной формуле

$$t_{\varphi} = \frac{C(n\varphi)}{24} \text{ нсек.}$$

Задний фронт задержанного импульса гораздо короче, т.к. в конце входного импульса ёмкость C быстро разряжается через вновь открывшийся триод модуля 1.

Согласование R_d больше 600 ом, т.к. это ухудшает условия выключения триода модуля 2.

II. ФОРМИРОВАНИЕ ИМПУЛЬСОВ ИЗ ФРОНТОВ

1. Формирование отрицательного импульса из отрицательного фронта

Номинал R_2 (рис.8) выбирается таким, чтобы триод модуля 2 был закрыт ($R_2 \leq 820$ ом). Длительность импульса на выходе схемы сильно зависит от величины R_2, C и, в меньшей степени, от величины R_1 . При уменьшении R_1 растёт скорость заряда ёмкости и первоначально прикладываемое к входу модуля 2 напряжение (рис.9). Поэтому отсечка импульса более резкая, задний фронт более крутой. Принимая $R_2 = 620$ ом, что обеспечивает уверенное запирание модуля 2, имеем

$$t_{\text{иых}} \approx C(nq) \cdot 10^{-3} \text{ мксек}$$

При $R_1 = 390$ ом задний фронт полученного импульса равен $0,2 t_{\text{иых}}$. Длительность переднего фронта на порядок меньше.

Пунктиром на графике рис.9 проиллюстрирован случай $R_1 = \infty$.

При повышении температуры $t_{\text{иых}}$ растёт. В этом отношении схема менее стабильна, чем описанная ниже, которая работает не на отпирание, а на запирание модуля 2.

2. Формирование положительного импульса из положительного фронта

Номинал R (рис.10) выбирается таким, чтобы триод модуля 2 был открыт ($R > 1,6$ ком). Импульс на выходе схемы появляется в момент открывания триода модуля 1. Когда он закрыт, происходит заряд ёмкости C через коллекторное сопротивление модуля 1. Условием нормальной работы схемы является полный заряд ёмкости C , т.е.

$$t_{\text{заряда}} \geq 3T$$

где $T = R_k C$; $R_k = 1,5$ ком.

Принимая $R = 3$ ком, имеем:

$$t_{\text{иых}} \approx 1,5 C \cdot 10^{-3} \text{ мксек}$$

Графики на рис.11 иллюстрируют работу вышеописанной схемы.

$$C = 1200 \text{ пф}$$

$$R = 3 \text{ ком}$$

$$t_{\text{иых}} = 1,7 \text{ мксек.}$$

Задний фронт получаемых импульсов

$$t_{3\phi} \approx 0,1 t_{\text{иых}}$$

Передний фронт — на порядок короче.

Описанная выше схема имеет более высокую температурную стабильность, чем предыдущая; поэтому, если необходимо получить отрицательный импульс на выходе, целесообразно применить схему рис.10 с выходным инвертором.

3. Формирование отрицательного импульса из положительного фронта (рис.12)

Графики (рис.13), построенные для случая

$$C = 6800 \text{ пф},$$

$$R_1 = 390 \text{ ом},$$

$$R_2 = 300 \text{ ом},$$

поясняют работу схемы. Импульс на выходе схемы появляется в момент, когда в точках 1 и 3 схемы напряжение больше 1,4 в; в остальное время триод модуля 2 закрыт.

Длительность импульса определяется временем разряда ёмкости C через открытый триод модуля 1 и сопротивление R_2

$$T \approx R_2 C$$

$$t_{\text{иых}} \approx 0,7 T$$

Сопротивление R_2 больше 820 ом брать не рекомендуется, т.к. ухудшаются условия запирания триода модуля 2.

Если необходимо обеспечить высокую частоту следования импульсов, то R_1 необходимо уменьшить, т.к.

$$t_{\text{иых}} = \text{const}$$

если ёмкость C успевает полностью зарядиться. Для этого необходимо, чтобы

$$t_{\text{иых}} \geq 3 T$$

заряда,

$$29e \quad T_{\text{заряда}} = \left(\frac{R_1 \cdot R_K}{R_1 + R_K} + R_2 \right) C$$

Передний фронт полученного импульса — короткий, задний — затянут.

$$t_{3,0} \approx 0,9 t_{\text{иых}}$$

Схема привлекает высокой температурной стабильностью.

III. МУЛЬТИВИБРАТОРЫ

Приведенный выше материал содержит основные приемы проектирования схем на модулях 2ЛБ172 серии 217. Поэтому в дальнейшем предлагается менее подробное описание схем.

1. Одновибраторы

В приведенной на рис.14 схеме

$$t_{\text{иых}} \approx 0,7 C_{(\text{пф})} \cdot 10^{-3} \text{ мксек}$$

Одновибратор запускается отрицательным фронтом. Если

$t_{\text{иых}} > t_{\text{иых}}$ (пунктир на рис.15), то длительность выходного импульса увеличивается примерно на 20%.

Уверенный запуск одновибратора происходит при

$$t_{\text{иых}} > 20 \text{ нсек.}$$

Одновибратор, собранный по схеме рис.16, имеет более высокую температурную стабильность; импульс на выходе — положительный. Запуск одновибратора — передним фронтом отрицательного импульса.

Недостаток схемы — в ограничении

$$t_{\text{иых}} \leq 0,5 t_{\text{иых}}$$

т.к. имеется потенциальная связь выхода со входом.

Формула для расчета ёмкости C :

$$t_{\text{иых}} = 2C_{(\text{пф})} \cdot 10^{-3} \text{ мксек}$$

Оба типа одновибраторов (рис.14 и рис.16) имеют

$$t_{\text{восст}} \approx 2t_{\text{иых}}$$

На рис.17 приведена схема одновибратора, отличающегося очень малым временем восстановления. По принципу работы этот одновибратор является триггером, в цепь сброса которого включена ёмкость C . При возбуждении триггера ёмкость C заряжается до +1,4 в, триод модуля 4 открывается, триггер сбрасывается и ёмкость C быстро разряжается через триод модуля 3.

Длительность импульса на выходе одновибратора равна времени заряда ёмкости C . Схема генерирует как положительный, так и отрицательный импульсы с чёткими фронтами; длительность и форма выходных импульсов не зависят от длительности запускающего импульса (рис.18)

$$t_{\text{иыхmin}} = 20 \text{ нсек}$$

$$t_{\text{восст}} = 0,1 t_{\text{иых}}$$

Формула для расчета ёмкости C (пф):

$$t_{\text{иых}} = 0,5 C \cdot 10^{-3} \text{ мксек.}$$

2. Генератор

Схема генератора приведена на рис.19. Генератор надежен в работе, четко синхронизуется управляющим сигналом. Диапазон частот достаточно широк:

$$10^{-1} - 10^7 \text{ гц.}$$

Величина ёмкостей C (мкф) и частота импульсов генератора

f (гц) связаны следующим соотношением:

$$f \cdot C \approx 3 \cdot 10^2$$

На низких частотах дополнительные сопротивления 470 ом, которые уменьшают степень насыщения транзисторов схемы, можно не ставить.

1У. СХЕМЫ ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНЫХ СЧЁТЧИКОВ

На рис.20 приведена схема триггера со счётным входом 2ТК171. Справа - его условное изображение.

На рис.21 приведена схема декады двоично-десятичного счётика, состоящая только из 4-х триггеров. Код - 1, 2, 4, 8. Максимальная рабочая скорость счёта

$$f_{max} = 4 \text{ мГц.}$$

Можно увеличить f_{max} вдвое, если установку четвертого триггера в состояние "1" производить по схеме рис.22.

Счётик, в котором применен принцип параллельной подачи счётного импульса на все триггеры, значительно сложнее. Повышение f_{max} в сравнении со схемой рис.22 незначительно. При работе со статистически распределенными импульсами на входе такого счётика необходимо включение формирователя счётного импульса с фиксированным мёртвым временем. Реализация схемы на печатной плате усложняется из-за наличия дополнительных модулей (управляющие ключи) и усложнённых связей. Применение такой схемы целесообразно при создании быстродействующего реверсивного счётика, т.к. схема реализует прибавление (или вычитание) единицы за время срабатывания одного триггера.

У. СИГНАЛИЗАЦИЯ

В качестве индикаторов рекомендуется использовать миниатюрные лампы накаливания НСМ-9-55 или НСМ-8-20, включаемые непосредственно к выходам модулей 2ЛБ172. Питание индикаторных цепей можно осуществлять нестабилизированным напряжением + 6 в.

Если необходима десятичная индикация двоично-десятичной декады счётика, обычно используют лампы серии ИН. В качестве

дешифраторов целесообразно применить модули серии 217 2ЛП173. Высоковольтными катодными ключами могут служить триоды П309 (рис.23).

У1. ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЕЙ СЕРИИ 217

Имеющийся опыт проектирования аппаратуры регистрации ВЭПП-3 позволяет оценить соотношение применяемых типов модулей серии 217:

Тип модуля	Схемное применение %
2ТК171	100
2ЛБ172	100
2ЛБ171	5
2ЛБ173	30
2ЛР171	10
2ЛП173	10
2НТ171	5
2TP171	20

Л и т е р а т у р а

1. Элементы ЭВМ на полупроводниковых приборах. Проектирование

и расчёт "Советское радио". Москва, 1969 г.

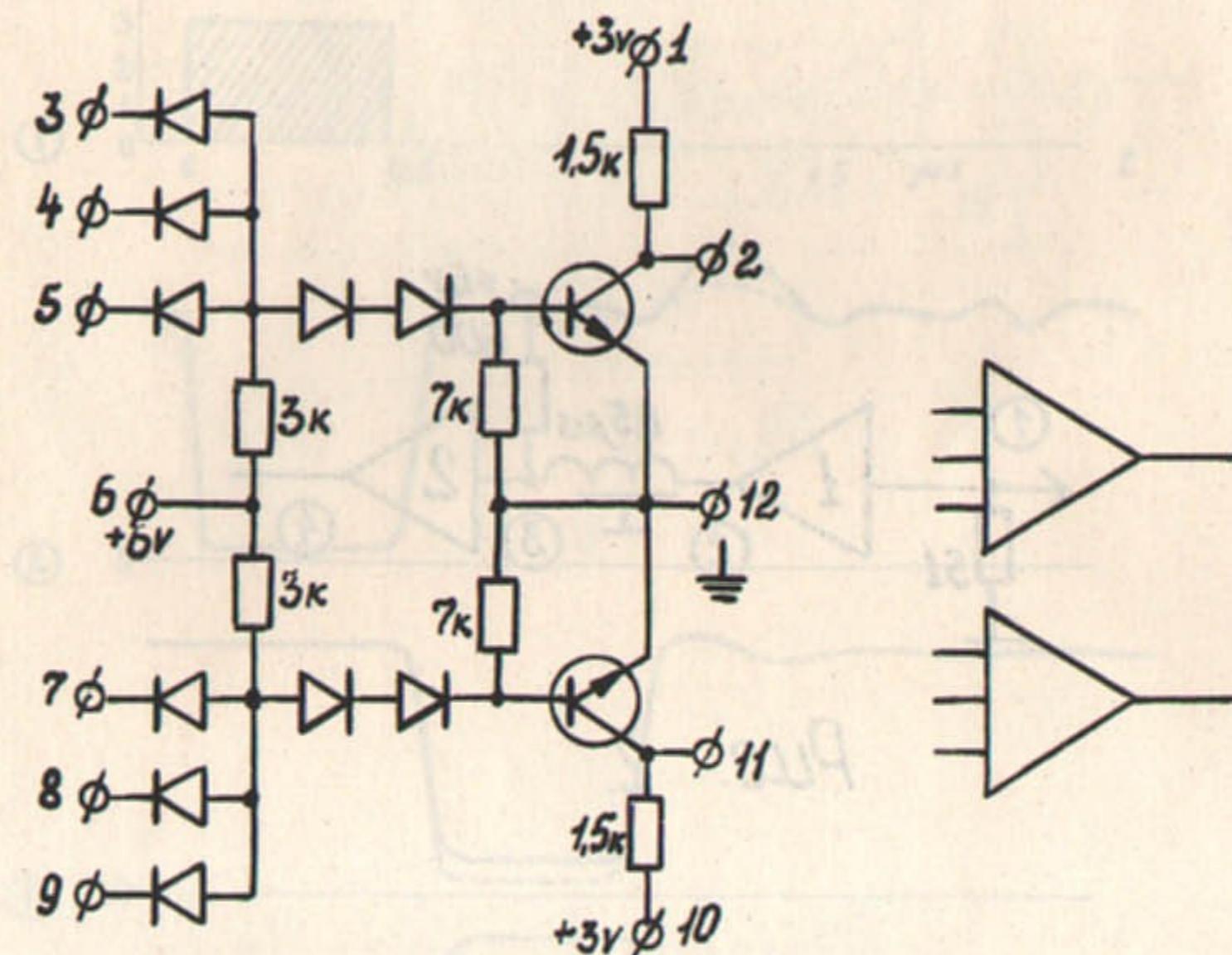


Рис. 1

Лабораторная работа № 2

1. Основные ОДН в измерительных схемах. Применение
в радио "Синтезатор пульса". Методы измерения.

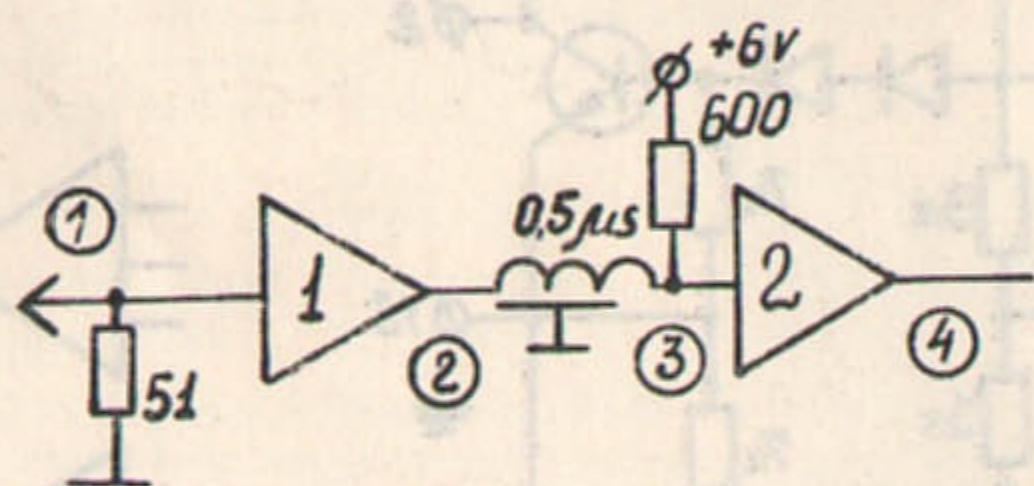


Рис. 2.

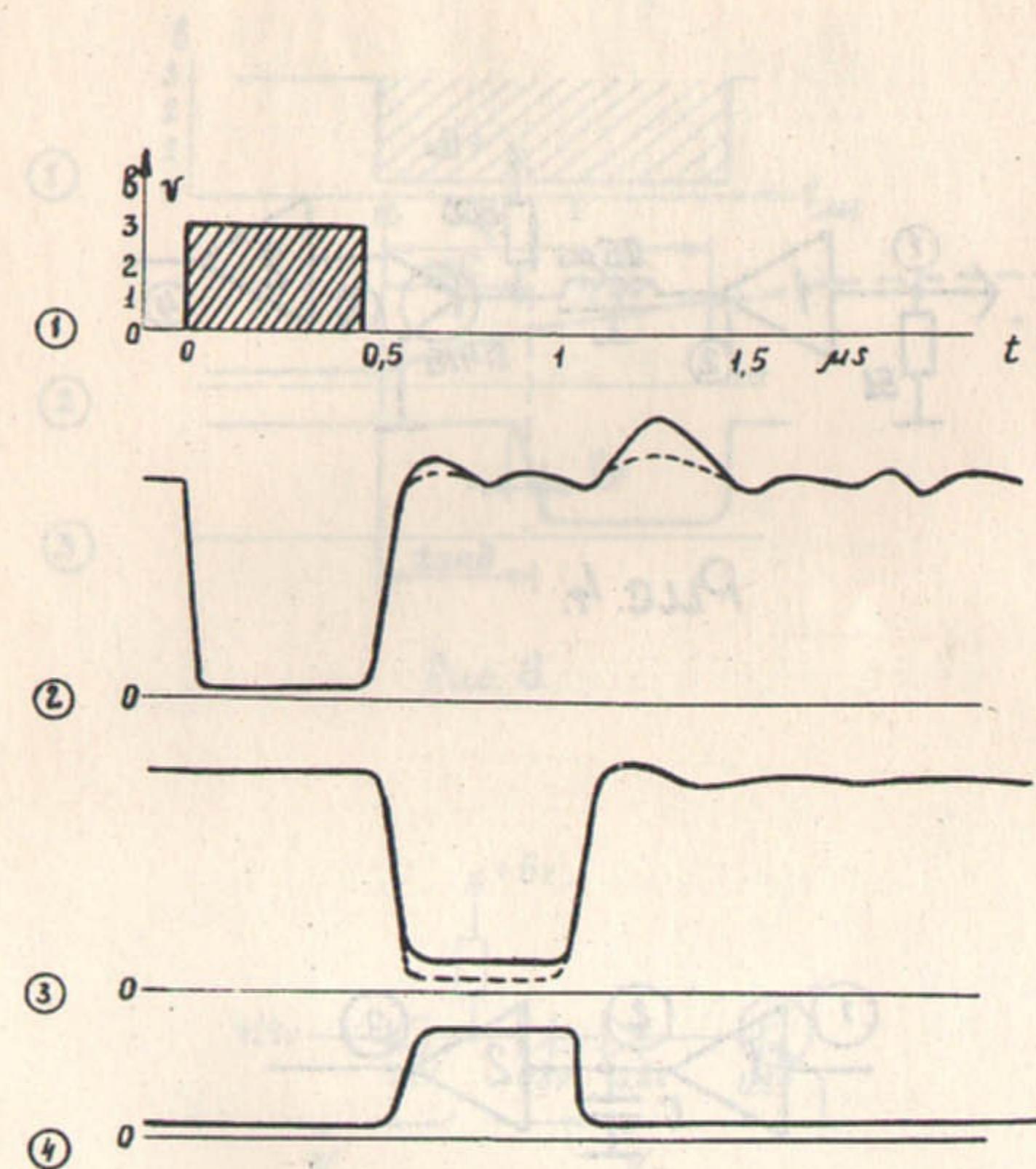


Рис. 3.

Рис. 7

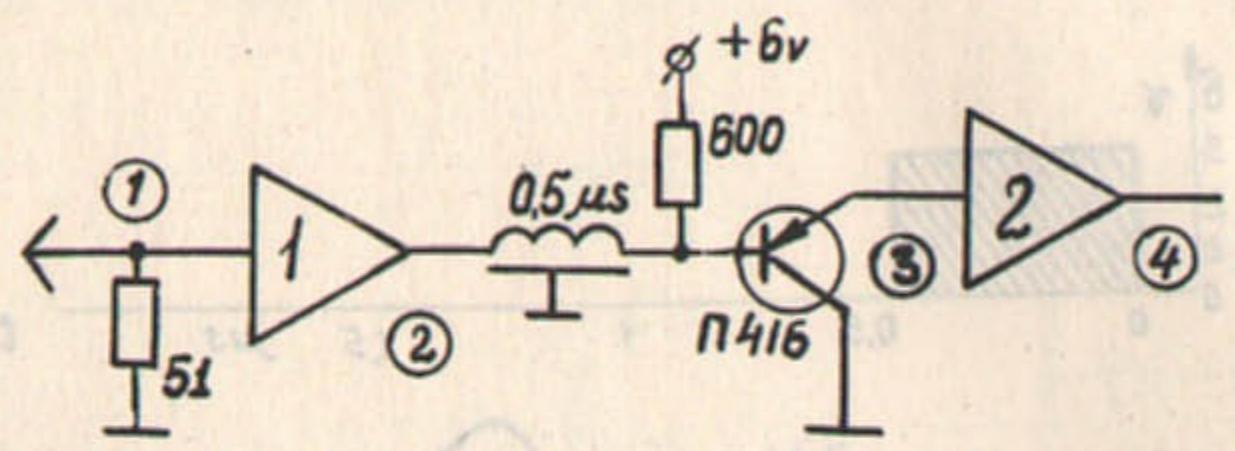


Рис. 4.

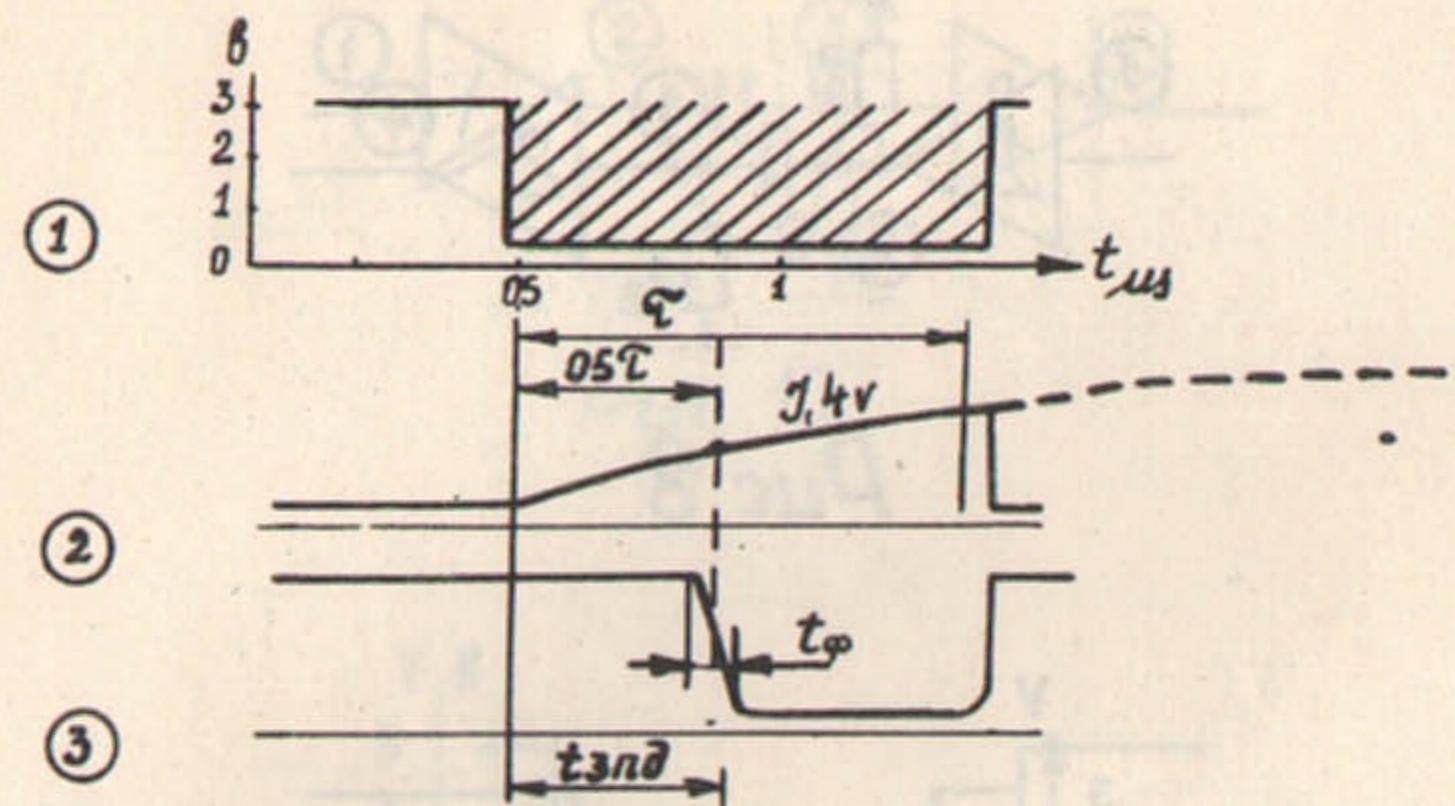


Рис. 6.

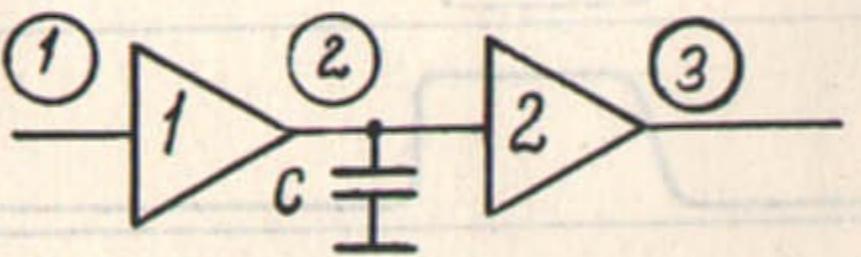


Рис. 5

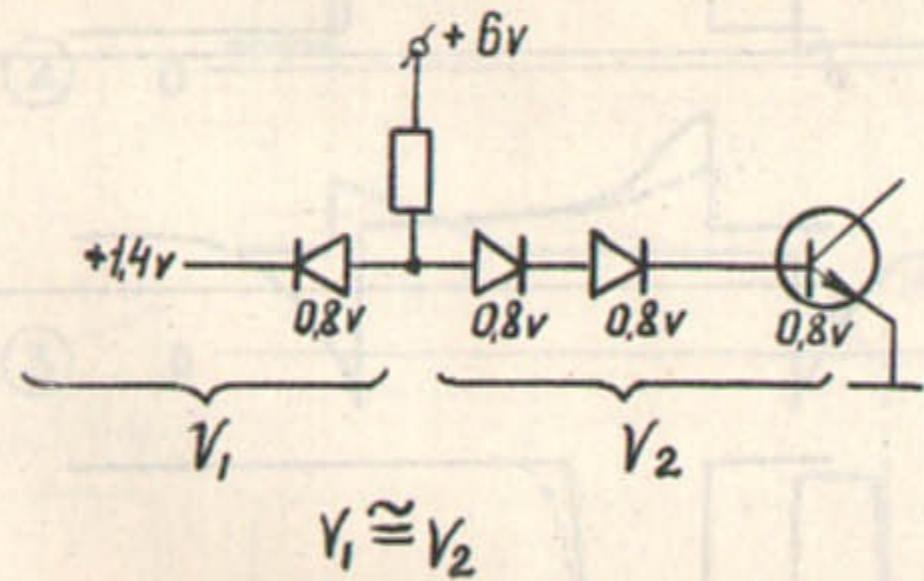
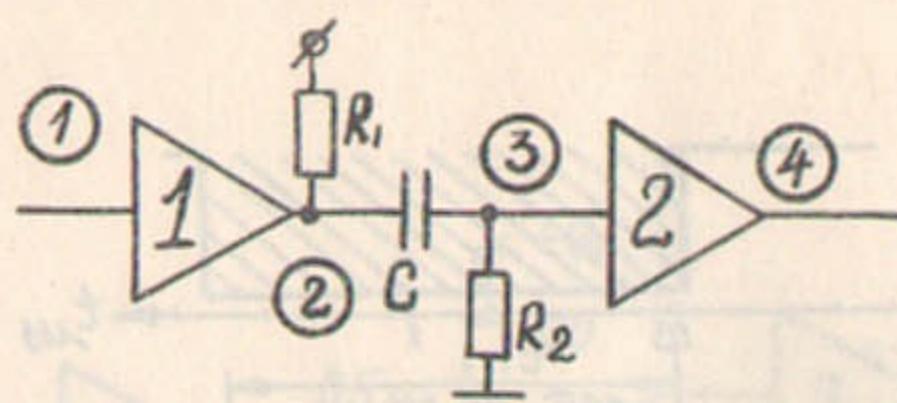
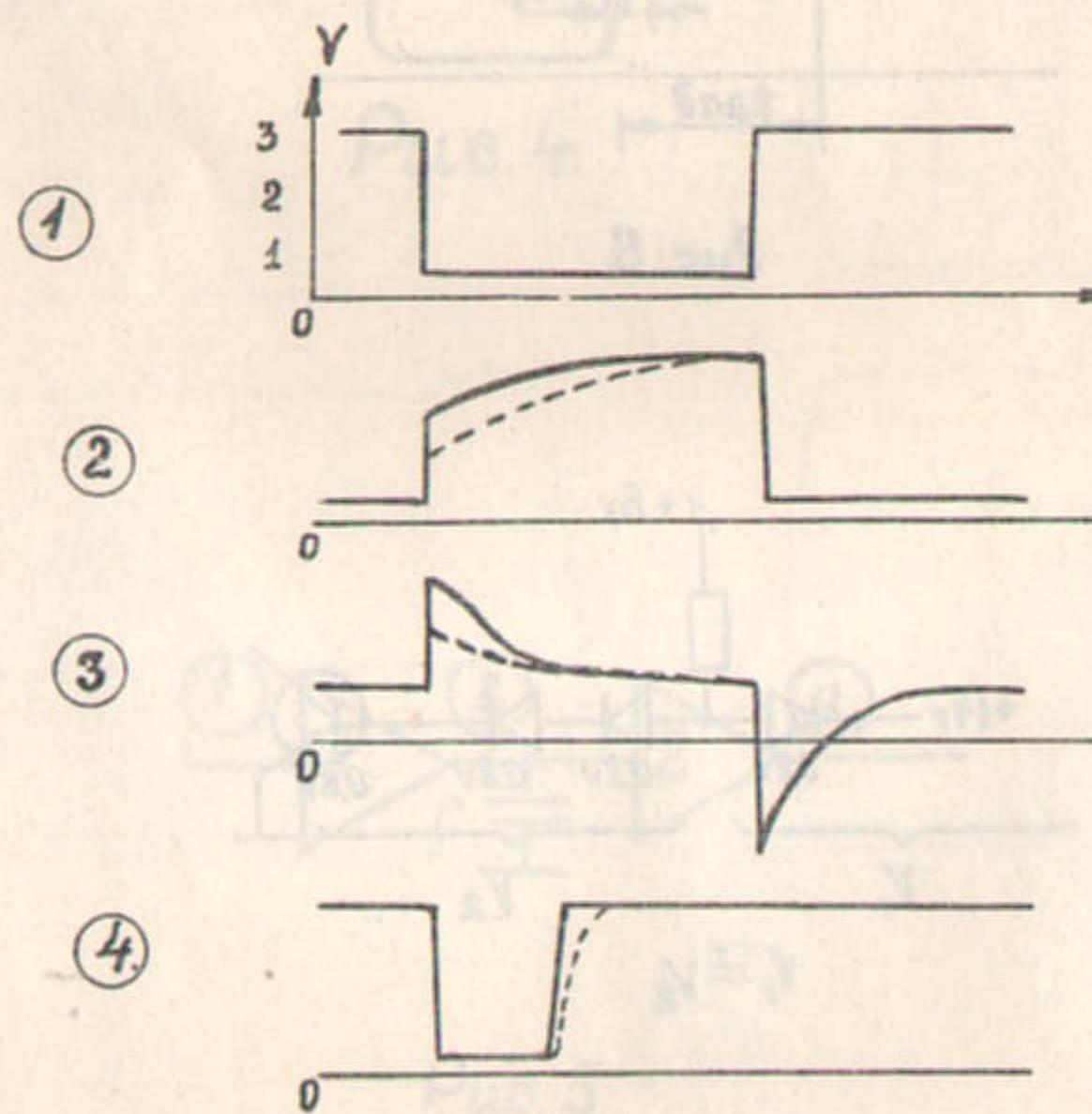


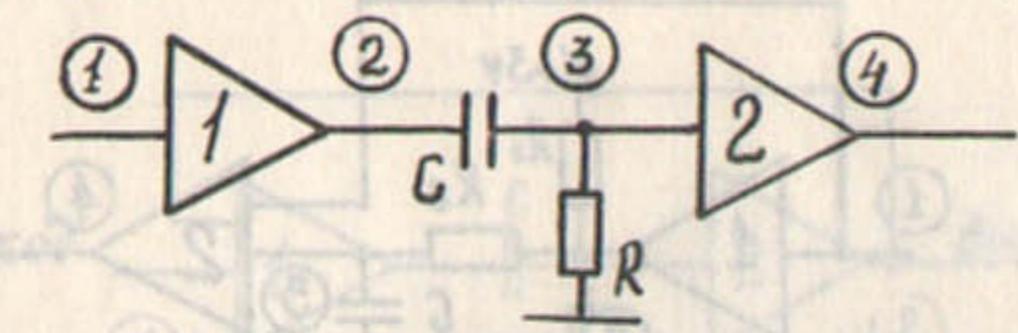
Рис. 7.



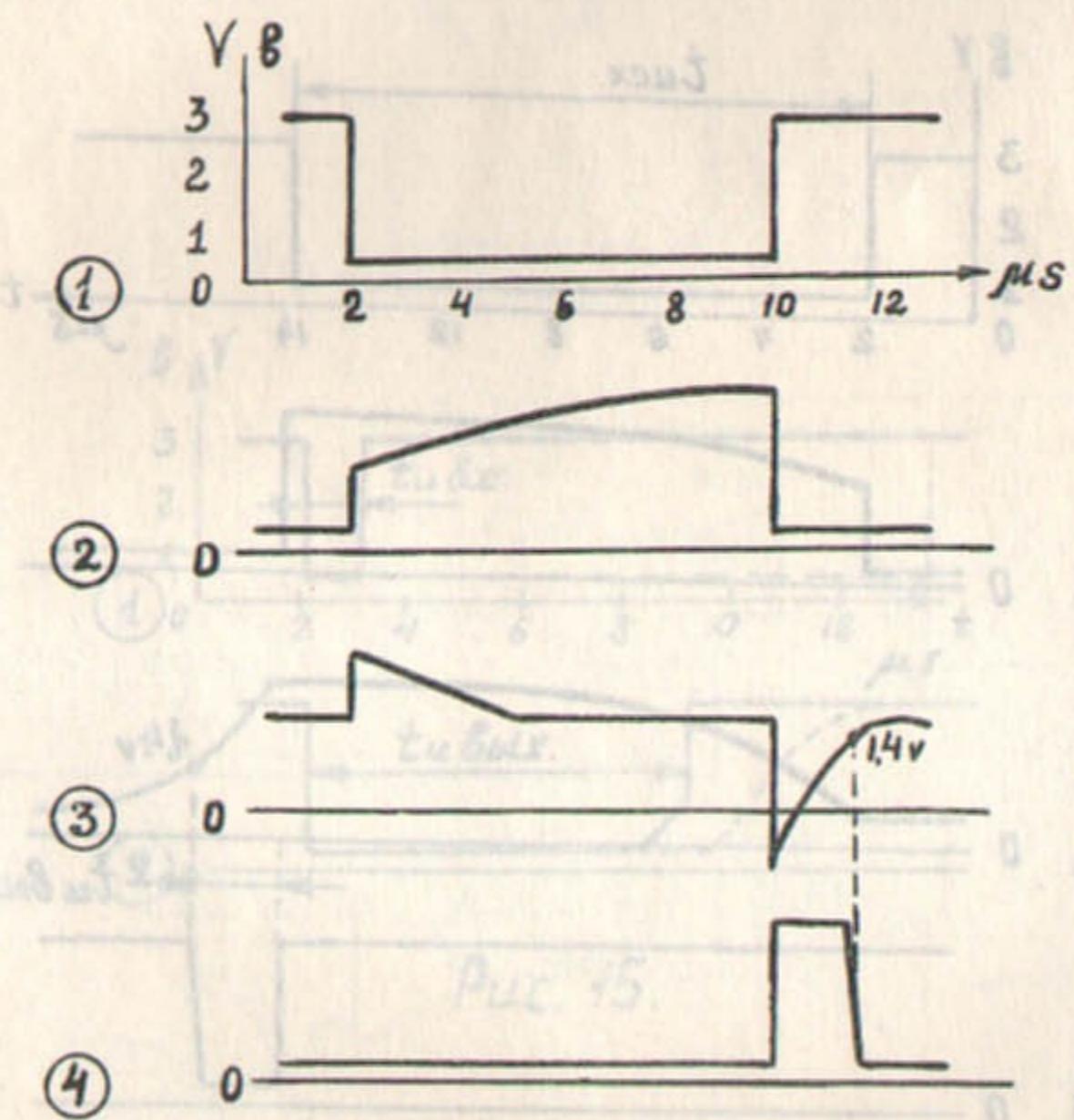
Puc. 8.



Puc. 9.



Puc. 10.



Puc. 11.

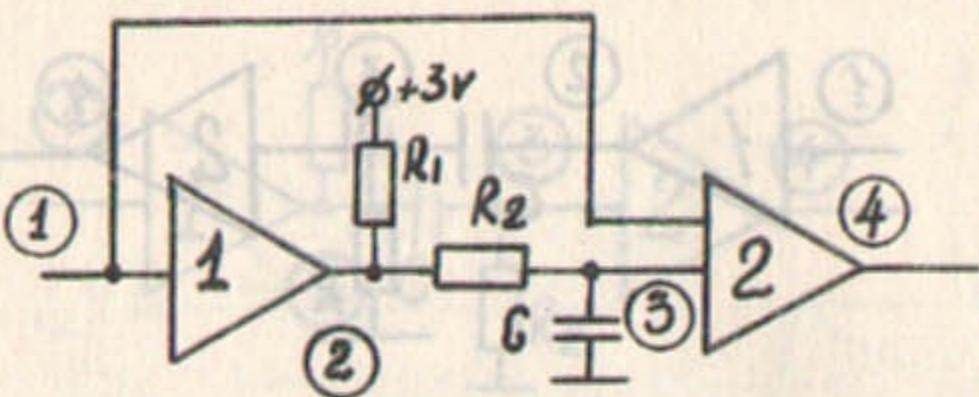


Рис. 12.

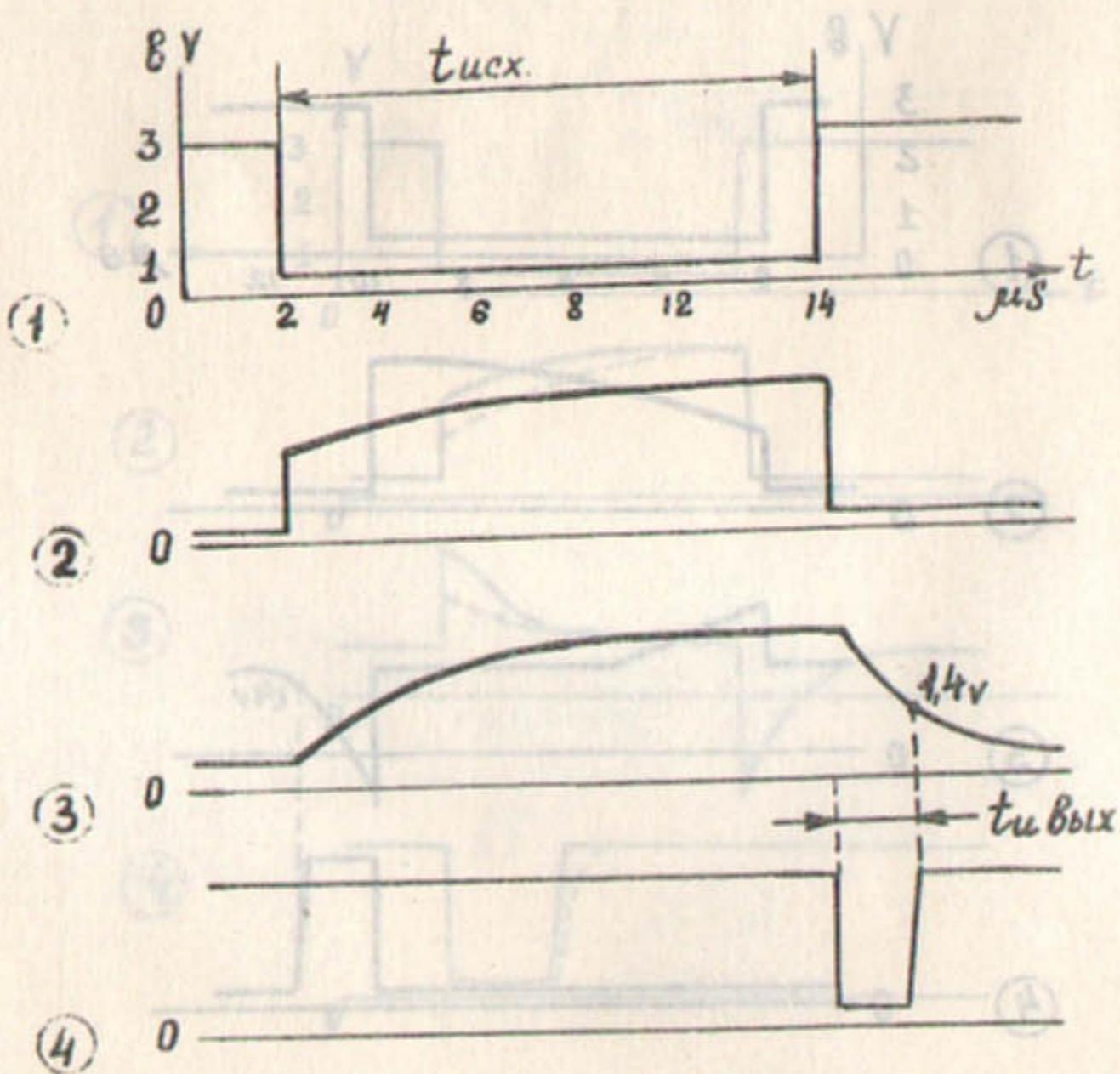


Рис. 13.

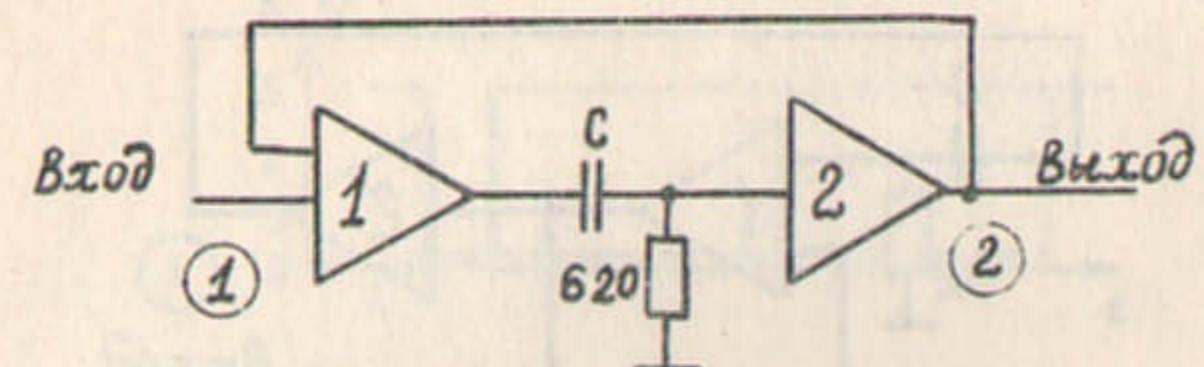


Рис. 14.

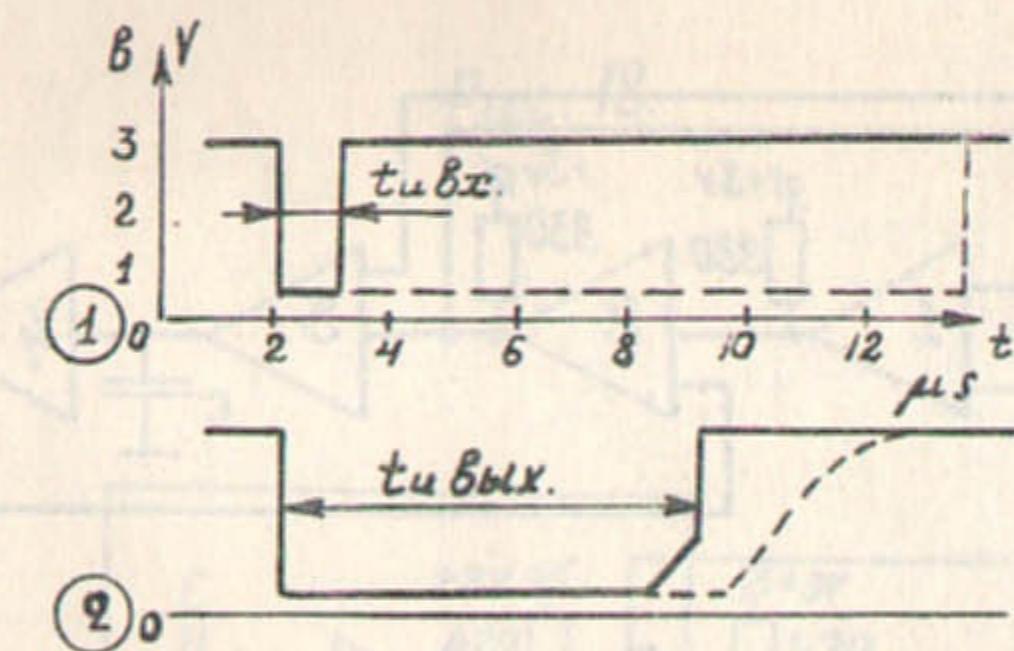


Рис. 15.

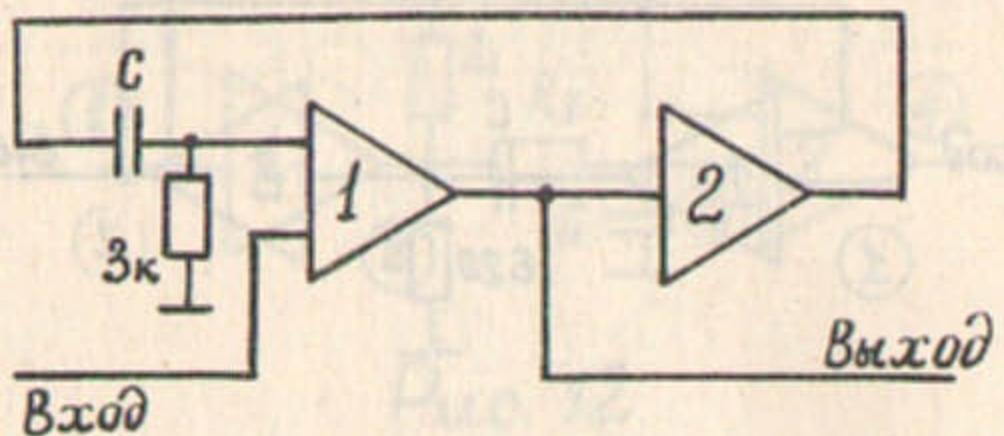


Рис. 16.

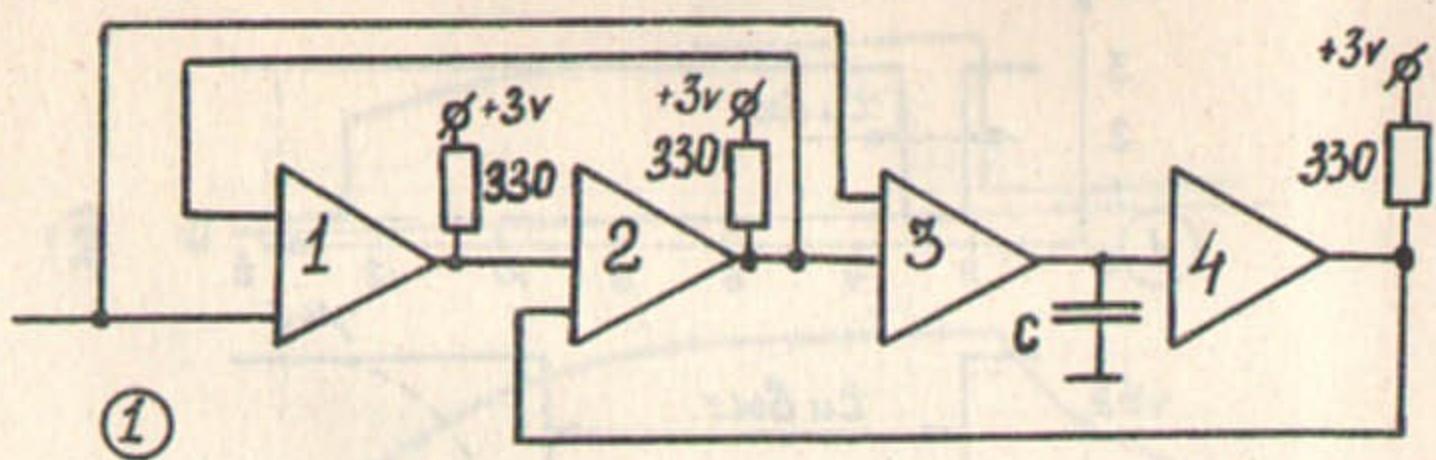


Рис. 17

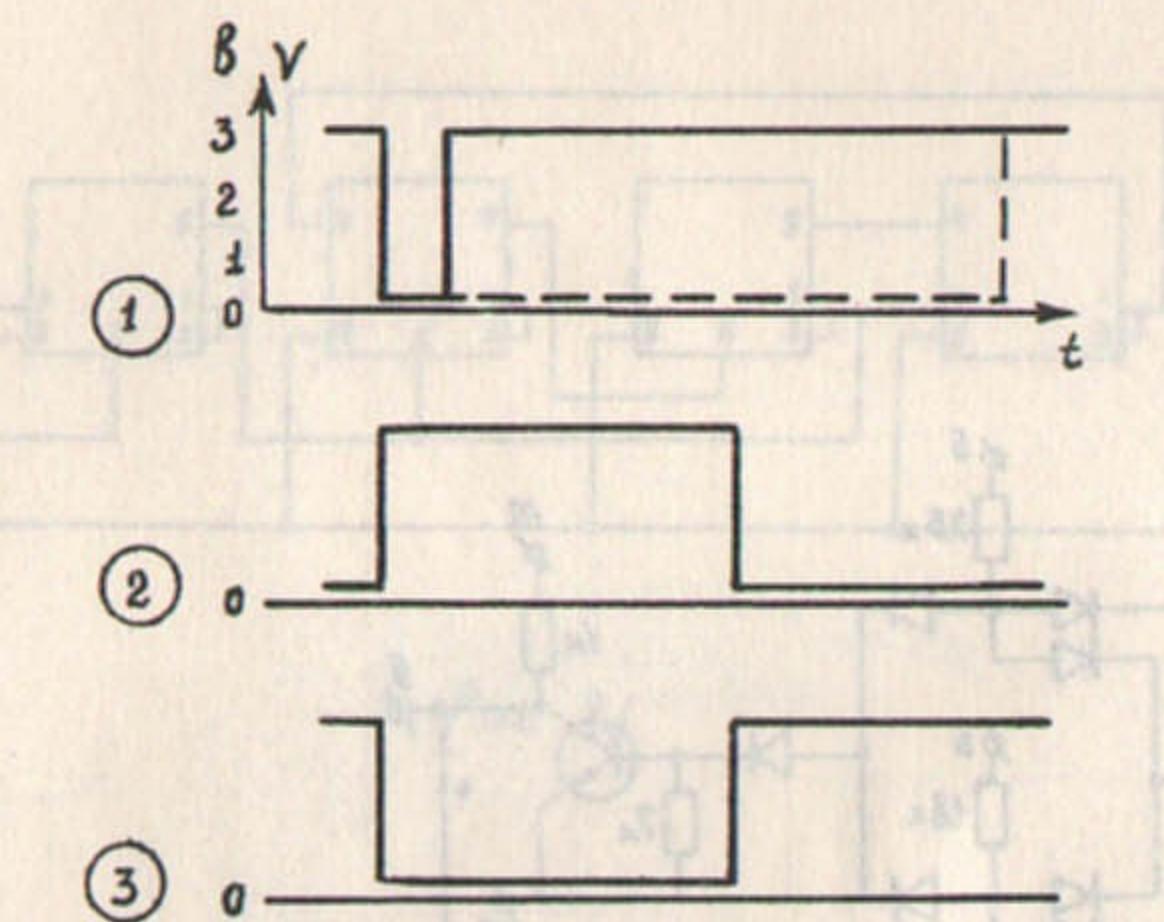


Рис. 18.

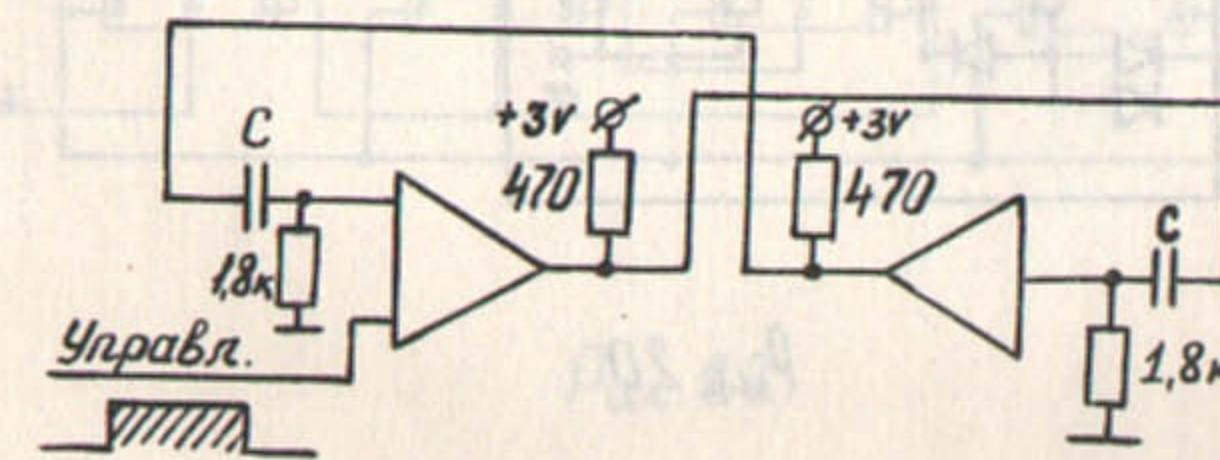


Рис. 19.

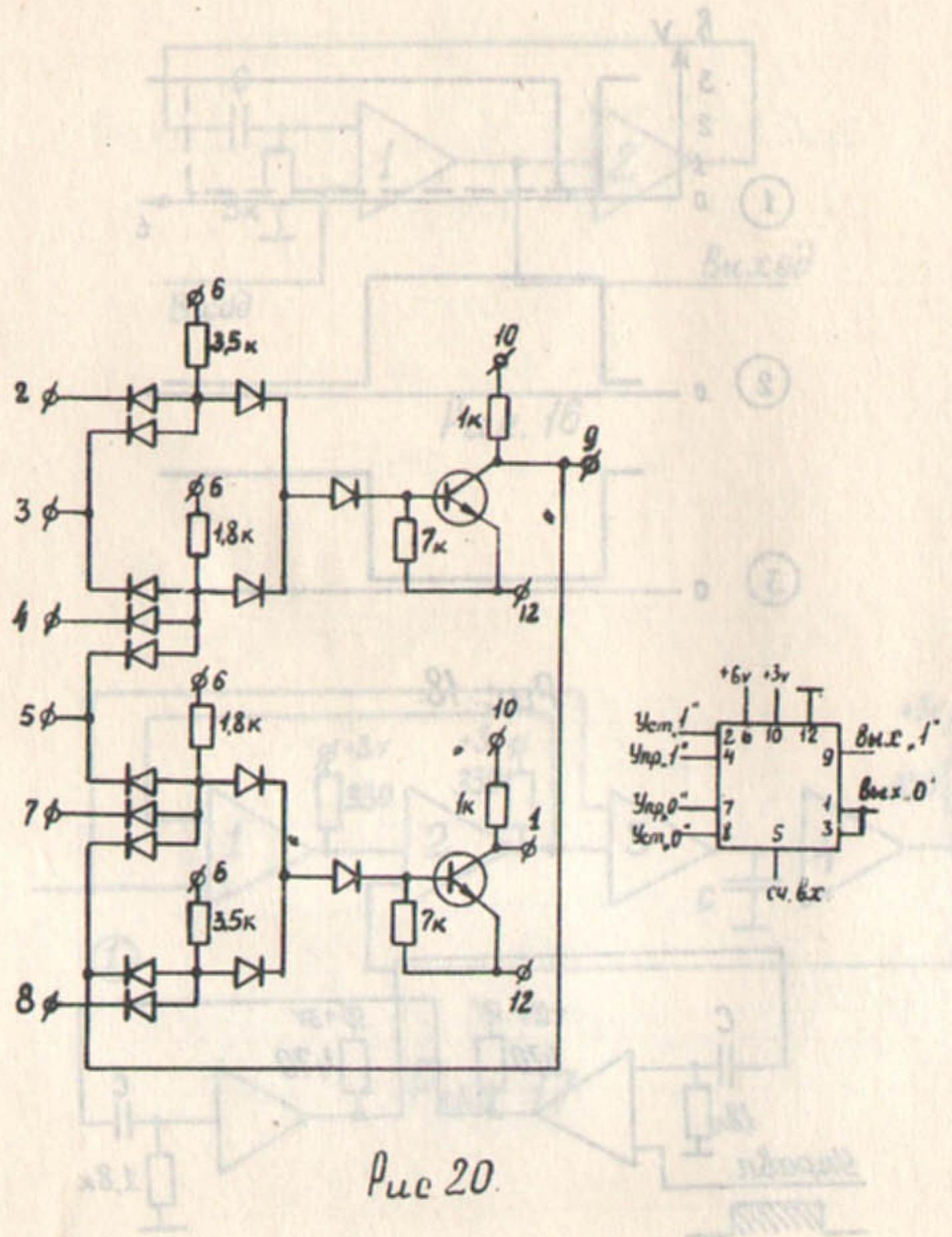


Рис. 20.

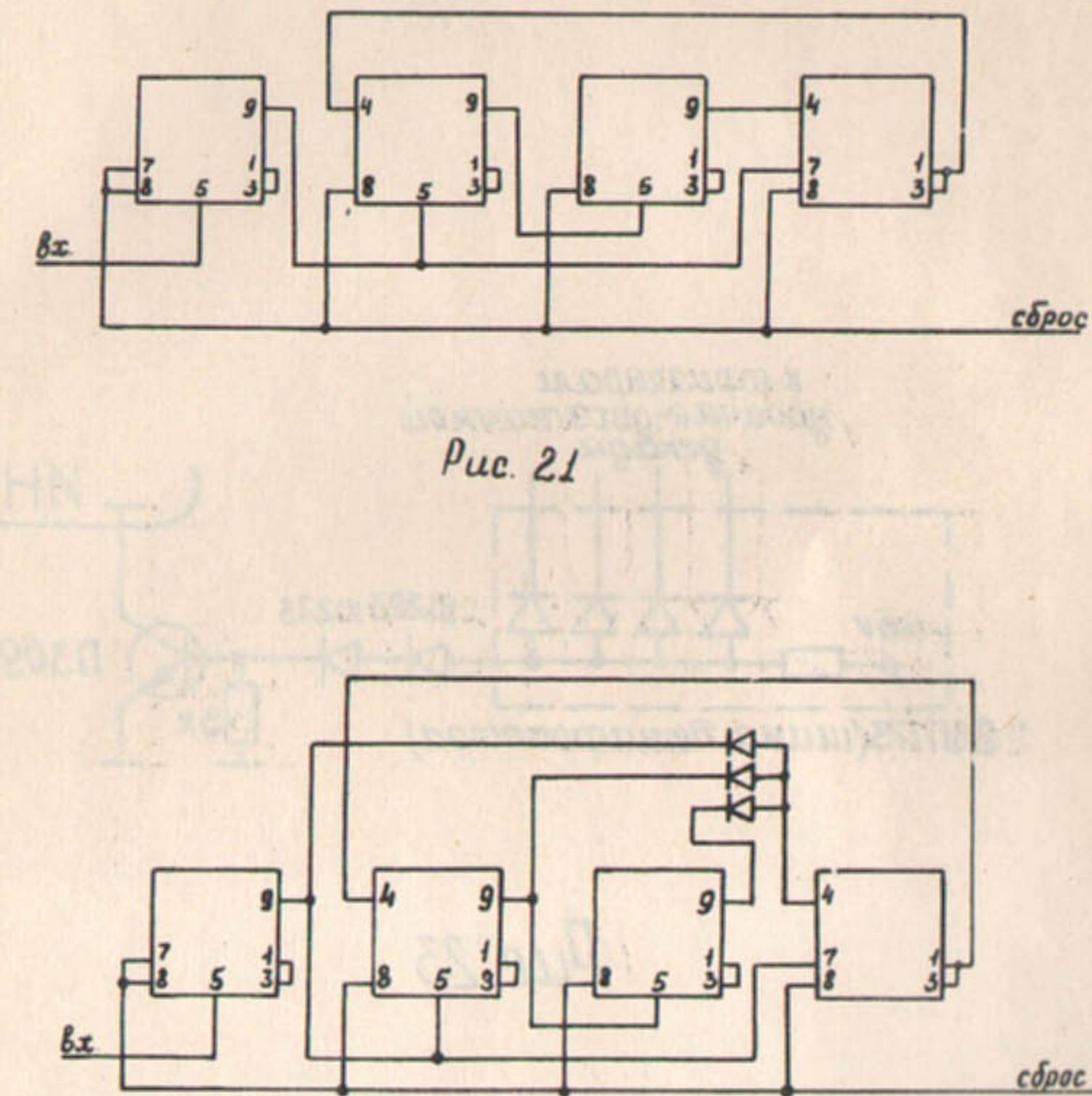


Рис. 22.

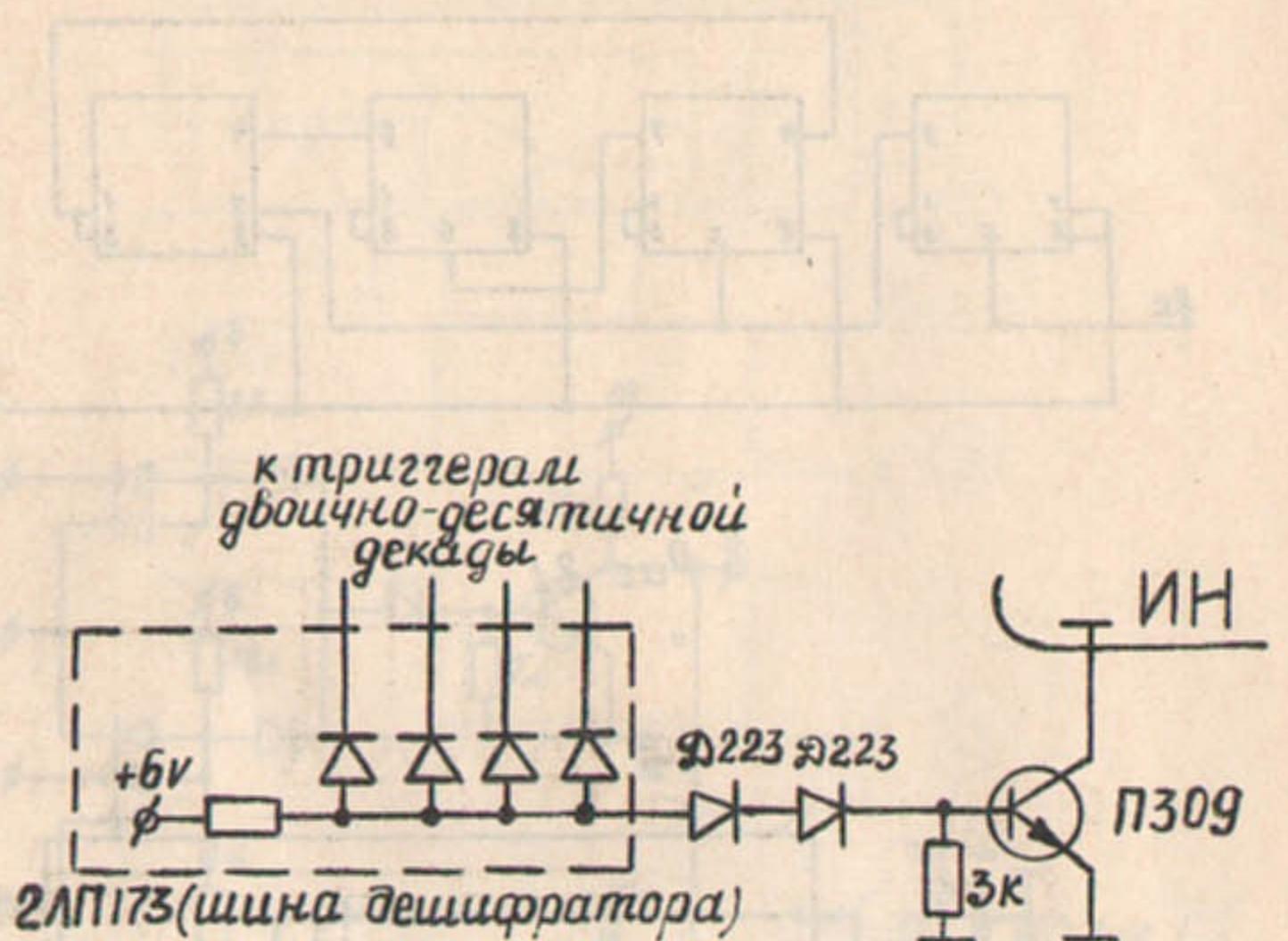


Рис. 23